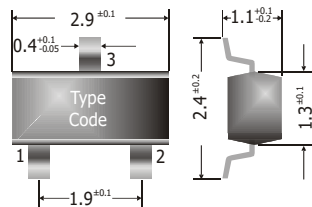


BAV23I, BAV23CA, BAV23CC, BAV23SE
SMD Small Signal Diodes
SMD Kleinsignal-Dioden
 $I_{FAV} = 225 \text{ mA}$ $V_{RRM} = 250 \text{ V}$
 $V_{F1} < 1 \text{ V}$ $I_{FSM} = 1.7 \text{ A}$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$ $t_{rr} < 50 \text{ ns}$

Version 2016-12-21

**SOT-23
(TO-236)**

Dimensions - Maße [mm]

Typical Applications
Signal processing, High-speed
switching, Rectifying
Commercial grade ¹⁾
Features
High reverse voltage
Superfast Recovery
Low junction capacity
Low leakage current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾
Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled

Weight approx.

Solder & assembly conditions

3000 / 7"

0.01 g

260°C/10s

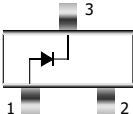
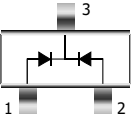
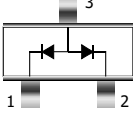
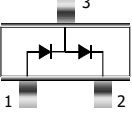
MSL = 1

Typische Anwendungen
Signalverarbeitung, Schnelles
Schalten, Gleichrichten
Standardausführung ¹⁾
Besonderheiten
Hohe Sperrspannung
Superschneller Sperrverzug
Niedrige Sperrschichtkapazität
Niedriger Sperrstrom
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾
Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle

Gewicht ca.

Löt- und Einbaubedingungen

BAV23I  Type Code HC 1 = A 2 = n. c. 3 = C	BAV23CC  Type Code PZ 1 = A1 2 = A2 3 = C1/C2
BAV23CA  Type Code RA 1 = C1 2 = C2 3 = A1/A2	BAV23SE  Type Code PY 1 = A1 2 = C2 3 = C1/A2

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

Power dissipation (per device) – Verlustleistung (pro Bauteil)	P_{tot}	350 mW ³⁾
Maximum average forward current Dauergrenzstrom	I_{FAV}	225 mA ³⁾ 125 mA ³⁾
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	625 mA ³⁾
Non repetitive peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	$t_p \leq 10 \text{ ms}$ $t_p \leq 100 \mu\text{s}$ $t_p \leq 1 \mu\text{s}$	1.7 A 3 A 9 A
Repetitive peak reverse voltage – Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	250 V
Reverse voltage – Sperrspannung	DC	V_R 200 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_S	-55...+150°C -55...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book

Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

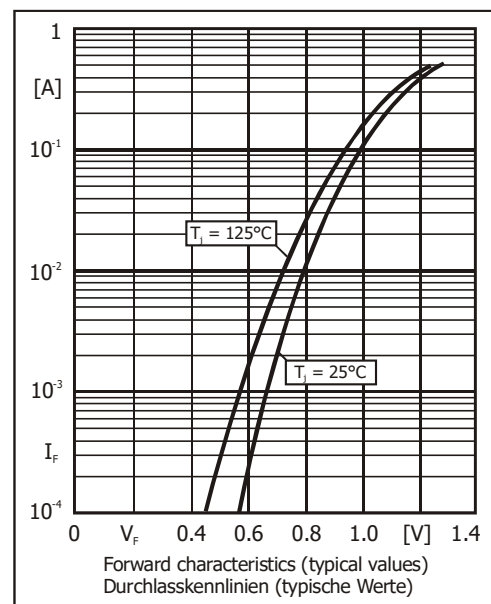
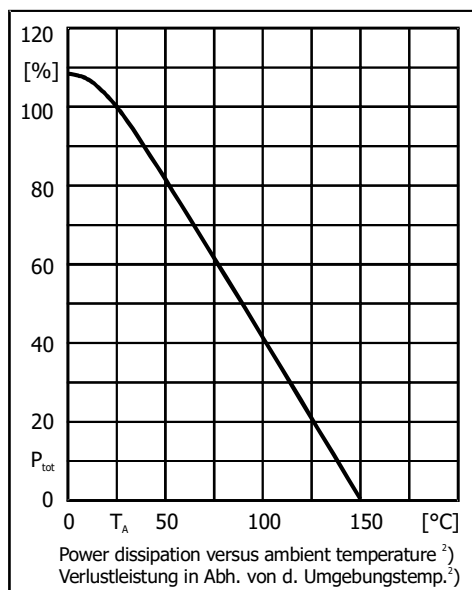
2 $T_A = 25^\circ\text{C}$ and per diode, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$ und pro Diode, wenn nicht anders angegeben

3 Mounted on 3 mm² copper pads per terminal – Montage auf 3 mm² Kupferbelag (Lötpads) je Anschluss

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 100\text{ mA}$ $I_F = 200\text{ mA}$	V_F	$< 1\text{ V}$ $< 1.25\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	$V_R = 200\text{ V}^1)$	I_R	$< 100\text{ nA}$ $< 100\text{ }\mu\text{A}$
Junction capacitance Sperrschichtkapazität		$V_R = 0\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	C_T	$< 5\text{ pF}$
Reverse recovery time Sperrverzögerung	$I_F = 30\text{ mA}$ über/through $I_R = 30\text{ mA}$ bis/to $I_R = 3\text{ mA}$		t_{rr}	$< 50\text{ ns}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 357\text{ K/W}^2)$



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$
Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
- 2 Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss